

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月9日(09.03.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/032928 A1

- (51) 国際特許分類:
C09G 1/02 (2006.01) B24B 37/00 (2012.01)
C09K 3/14 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/032451
- (22) 国際出願日: 2022年8月29日(29.08.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
PCT/JP2021/031892 2021年8月31日(31.08.2021) JP
PCT/JP2021/031894 2021年8月31日(31.08.2021) JP
特願 2022-088818 2022年5月31日(31.05.2022) JP
- (71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 荒田 彰吾 (ARATA Shogo); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 坂下 雅弘 (SAKASHITA Masahiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 市毛 康裕 (ICHIGE Yasuhiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 星 陽介 (HOSHI Yousuke); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: POLISHING LIQUID, POLISHING METHOD, COMPONENT MANUFACTURING METHOD, AND SEMICONDUCTOR COMPONENT MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨液、研磨方法、部品の製造方法、及び、半導体部品の製造方法

(57) Abstract: Provided is a polishing liquid for polishing a member to be polished, said polishing liquid containing abrasive grains which include a cerium oxide, wherein the member to be polished contains a resin and particles which include a silicon compound. Also provided is a polishing method in which the polishing liquid is used to polish a member to be polished that contains a resin and particles including a silicon compound. Also provided is a component manufacturing method in which a member to be polished that has been polished by the polishing method is used to obtain a component. Also provided is a semiconductor component manufacturing method in which a member to be polished that has been polished by the polishing method is used to obtain a semiconductor component.

(57) 要約: 被研磨部材の研磨用の研磨液であって、セリウム酸化物を含む砥粒を含有し、前記被研磨部材が、樹脂と、ケイ素化合物を含む粒子と、を含有する、研磨液。当該研磨液を用いて、樹脂と、ケイ素化合物を含む粒子と、を含有する被研磨部材を研磨する、研磨方法。当該研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る、部品の製造方法。前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。

WO 2023/032928 A1